

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【公開番号】特開2006-261636(P2006-261636A)  
 【公開日】平成18年9月28日(2006.9.28)  
 【年通号数】公開・登録公報2006-038  
 【出願番号】特願2005-344679(P2005-344679)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/28 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/285 (2006.01)  
 G 0 2 F 1/1368 (2006.01)  
 C 2 3 C 14/34 (2006.01)  
 C 2 2 C 21/00 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 29/78 6 1 6 V  
 H 0 1 L 21/28 3 0 1 R  
 H 0 1 L 21/285 S  
 G 0 2 F 1/1368  
 C 2 3 C 14/34 A  
 C 2 2 C 21/00 N

【手続補正書】  
 【提出日】平成20年1月17日(2008.1.17)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

薄膜トランジスタと透明画素電極を有し、A l 合金膜と酸化物導電膜が、高融点金属を介さずに直接接続しており、その接触界面に A l 合金成分の一部または全部が析出もしくは濃化して存在する薄膜トランジスタ基板であって、

前記 A l 合金膜は、合金成分として、グループ に属する元素を 0 . 1 原子%以上 6 原子%以下、およびグループ X に属する元素を 0 . 1 原子%以上 2 . 0 原子%以下の範囲で含有する A l - - X 合金からなり、前記グループ は、N i , A g , Z n , C u , および G e よりなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、前記グループ X は、L a および / または G d の元素であることを特徴とする薄膜トランジスタ基板。

【請求項 2】

前記 A l 合金膜は、2 5 0 で 3 0 分加熱したときの電気抵抗率が  $7 \mu \cdot \text{cm}$  以下である請求項 1 に記載の薄膜トランジスタ基板。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の薄膜トランジスタ基板を備えた表示デバイス。

【請求項 4】

合金成分として、グループ に属する元素を 0 . 1 原子%以上 6 原子%以下、およびグループ X に属する元素を 0 . 1 原子%以上 2 . 0 原子%以下の範囲で含有する A l - - X 合金からなり、前記グループ は、N i , A g , Z n , C u , および G e よりなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、前記グループ X は、L a および / または G d

の元素であることを特徴とする表示デバイス用のスパッタリングターゲット。